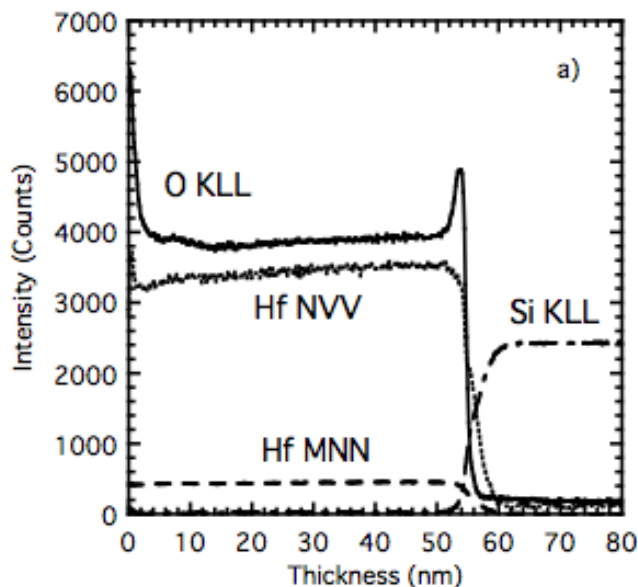


研究論文, ” 極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO₂/Si基板の分析” に掲載されている Fig.6
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

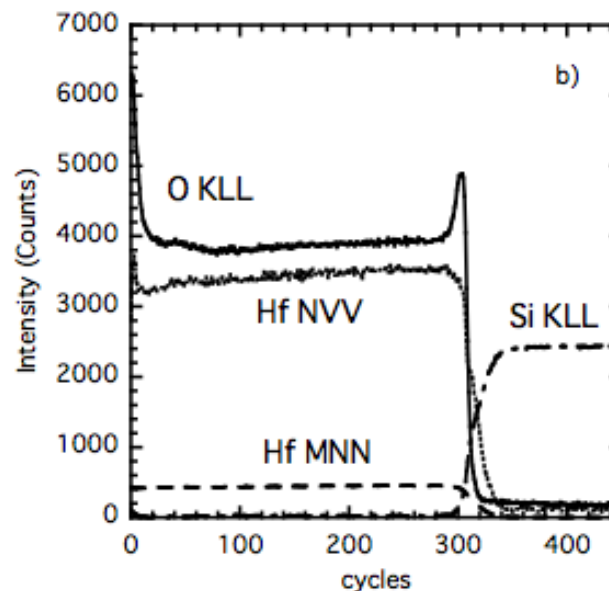
DOI

<https://doi.org/10.1384/jsa.24.192>

荻原俊弥, 長田貴弘, 吉川英樹, *J. Surf. Anal.* **24**, 192 (2018).



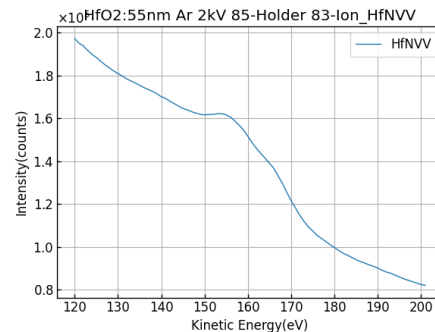
AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate using the ultra low angle incident beam method with the argon ion energy of 2.0 keV. Horizontal axis is nm.



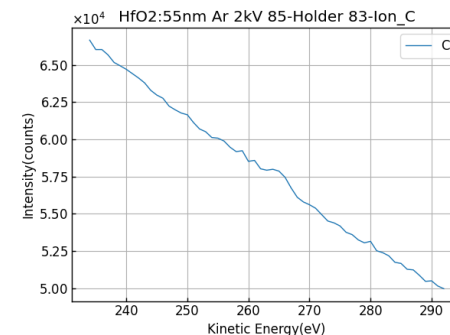
AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate using the ultra low angle incident beam method with the argon ion energy of 2.0 keV. Horizontal axis is cycles.

- a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig.6 に相当し, 横軸は nm である.
b) は横軸を測定回数で表したものであり, 横軸を nm に変換する前のプロファイルである.
Raw data ファイルは, b) に対応している.

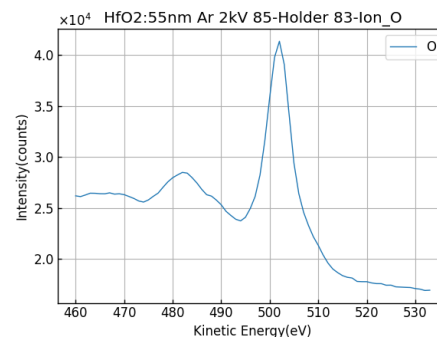
Energy (eV)	Intensity		
120	197099	164	141409
121	195050	165	139055
122	193708	166	136670
123	191685	167	133126
124	189787	168	129695
125	188337	169	125512
126	186624	170	121613
127	184979	171	118274
128	183507	172	114784
129	182114	173	111932
130	180847	174	109385
131	179714	175	107433
132	178388	176	105497
133	177403	177	103992
134	176468	178	102599
135	175376	179	101109
136	174311	180	99762
137	173396	181	98419
138	172557	182	97098
139	171437	183	96206
140	170075	184	95184
141	169298	185	94117
142	167954	186	93208
143	166866	187	92534
144	165644	188	91707
145	164623	189	90998
146	163900	190	90232
147	163101	191	89234
148	162442	192	88324
149	161841	193	87821
150	161567	194	86924
151	161756	195	86079
152	161815	196	85229
153	162165	197	84515
154	162156	198	83877
155	161597	199	83236
156	160575	200	82514
157	158809	201	82169
158	156778		
159	154570		
160	151672		
161	148670		
162	145987		
163	143619		



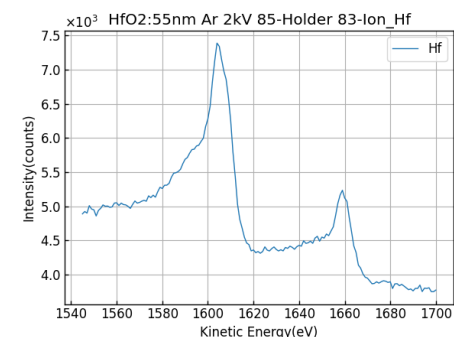
Raw data of Hf-NVV



Raw data of C



Raw data of O



Raw data of Hf

Raw data の図化

Hf-NVV Raw data ファイルの構造